

## TSDxx 単方向 TVS ダイオード、SOD-323 パッケージ

### 1 特長

- IEC 61000-4-2 ESD 保護:
  - $\pm 30\text{kV}$  接触放電
  - $\pm 30\text{kV}$  エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ保護:
  - $7\text{-}60\text{A}$  ( $8/20\mu\text{s}$ )
- IO 容量 <  $20\text{pF}$  (標準値)
- 超低リーク電流:  $50\text{nA}$  (最大値)
- 産業用温度範囲:  $-55^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
- 業界標準の SOD-323 リード付きパッケージ ( $2.65\text{mm} \times 1.3\text{mm}$ )

### 2 アプリケーション

- I/O 保護
- 電源ライン保護
- **USB VBUS**
- **グリッド インフラ**
- **ポータブル エレクトロニクス**

### 3 説明

TSDxx は単方向 TVS 保護ダイオードのファミリーであり、ESD やサージなどの有害な過渡電圧をクランプするように設計されています。TSDxx デバイスは、最大  $\pm 30\text{kV}$  の ESD (接触放電とエアギャップ放電) を放散する定格を備えており、IEC 61000-4-2 国際規格 (レベル 4) で規定されている最大レベルもクリアしています。

このデバイスの堅牢なクランプ性能と低容量を組み合わせることで TSDxx は、優れた TVS ダイオードとなり、多くの異なるアプリケーションでデータと電源ラインの両方を保護します。

TSDxx は、業界標準のリード付き SOD-323 パッケージで供給され、半田付けが容易です。

#### パッケージ情報

| 部品番号  | パッケージ (1)        | パッケージ サイズ (2)                       |
|-------|------------------|-------------------------------------|
| TSDxx | DYF (SOD-323, 2) | $2.65\text{mm} \times 1.3\text{mm}$ |

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。



機能ブロック図



## 目次

|                            |          |                                    |           |
|----------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1 特長</b> .....          | <b>1</b> | 5.12 電気的特性 - TSD36.....            | <b>8</b>  |
| <b>2 アプリケーション</b> .....    | <b>1</b> | 5.13 代表的特性.....                    | <b>9</b>  |
| <b>3 説明</b> .....          | <b>1</b> | <b>6 アプリケーションと実装</b> .....         | <b>11</b> |
| <b>4 ピン構成および機能</b> .....   | <b>3</b> | 6.1 アプリケーション情報.....                | <b>11</b> |
| <b>5 仕様</b> .....          | <b>4</b> | <b>7 デバイスおよびドキュメントのサポート</b> .....  | <b>11</b> |
| 5.1 絶対最大定格.....            | 4        | 7.1 ドキュメントのサポート.....               | 11        |
| 5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様..... | 4        | 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....        | 11        |
| 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様.....   | 4        | 7.3 サポート・リソース.....                 | 11        |
| 5.4 推奨動作条件.....            | 4        | 7.4 商標.....                        | 11        |
| 5.5 熱に関する情報.....           | 5        | 7.5 静電気放電に関する注意事項.....             | 11        |
| 5.6 電気的特性 - TSD03.....     | 5        | 7.6 用語集.....                       | 11        |
| 5.7 電気的特性 - TSD05.....     | 6        | <b>8 改訂履歴</b> .....                | <b>12</b> |
| 5.8 電気的特性 - TSD12.....     | 6        | <b>9 メカニカル、パッケージ、および注文情報</b> ..... | <b>13</b> |
| 5.9 電気的特性 - TSD15.....     | 7        | 9.1 テープおよびリール情報.....               | 13        |
| 5.10 電気的特性 - TSD18.....    | 7        | 9.2 メカニカル データ.....                 | 15        |
| 5.11 電気的特性 - TSD24.....    | 8        |                                    |           |

## 4 ピン構成および機能

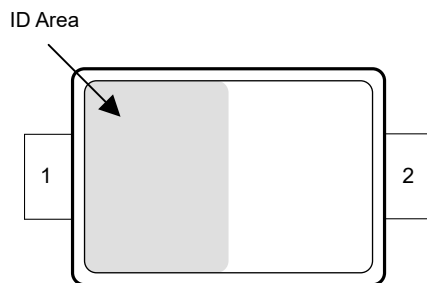


図 4-1. DYF パッケージ、2 ピン SOD-323 (上面図)

表 4-1. ピンの機能

| ピン |     | 種類 <sup>(1)</sup> | 説明               |
|----|-----|-------------------|------------------|
| 番号 | 名称  |                   |                  |
| 1  | IO  | I/O               | 保護されたチャネル        |
| 2  | GND | GND               | グランド。グランドに接続します。 |

(1) I = 入力、O = 出力。GND = グランド

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ            |                                                    | デバイス  | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|------------------|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|----|
| P <sub>PP</sub>  | 25°Cでの IEC 61000-4-5 の電力 (t <sub>p</sub> – 8/20μs) | TSD03 |     | 170 | W  |
|                  |                                                    | TSD05 |     | 529 | W  |
|                  |                                                    | TSD12 |     | 300 | W  |
|                  |                                                    | TSD15 |     | 300 | W  |
|                  |                                                    | TSD18 |     | 300 | W  |
|                  |                                                    | TSD24 |     | 250 | W  |
|                  |                                                    | TSD36 |     | 300 | W  |
| I <sub>PP</sub>  | 25°Cでの IEC 61000-4-5 の電流 (t <sub>p</sub> – 8/20μs) | TSD03 |     | 25  | A  |
|                  |                                                    | TSD05 |     | 60  | A  |
|                  |                                                    | TSD12 |     | 18  | A  |
|                  |                                                    | TSD15 |     | 15  | A  |
|                  |                                                    | TSD18 |     | 15  | A  |
|                  |                                                    | TSD24 |     | 9   | A  |
|                  |                                                    | TSD36 |     | 7   | A  |
| T <sub>A</sub>   | 動作時周囲温度                                            |       | -55 | 150 | °C |
| T <sub>stg</sub> | 保管温度                                               |       | -65 | 155 | °C |

- (1) 絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。推奨動作条件の範囲外ではあるが、絶対最大定格の範囲内で短時間動作している場合、デバイスは損傷を受けない可能性があります、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。

### 5.2 ESD 定格 - JEDEC 仕様

|                    |      |                                                       | 値     | 単位 |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------|-------|----|
| V <sub>(ESD)</sub> | 静電放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠 <sup>(1)</sup> | ±2500 | V  |
|                    |      | デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JS-002 に準拠 <sup>(2)</sup>    | ±1000 | V  |

- (1) JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。  
(2) JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。

### 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様

|                    |      |                    | 値      | 単位 |
|--------------------|------|--------------------|--------|----|
| V <sub>(ESD)</sub> | 静電放電 | IEC 61000-4-2 接触放電 | ±30000 | V  |
|                    |      | IEC 61000-4-2 気中放電 | ±30000 |    |

### 5.4 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

|                |            | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 |
|----------------|------------|-----|-----|-----|----|
| T <sub>A</sub> | 自由空気での動作温度 | -55 |     | 150 | °C |

## 5.5 熱に関する情報

| 熱評価基準 <sup>(1)</sup> |                     | TSD03         | TSD05         | TSD12 / TSD15 / TSD18 /<br>TSD24 / TSD36 | 単位   |
|----------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|------|
|                      |                     | DYF (SOD-323) | DYF (SOD-323) | DYF (SOD-323)                            |      |
|                      |                     | 2 ピン          | 2 ピン          | 2 ピン                                     |      |
| $R_{\theta JA}$      | 接合部から周囲への熱抵抗        | 739.2         | 672.0         | 693.9                                    | °C/W |
| $R_{\theta JC(top)}$ | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 287.7         | 230.5         | 254.7                                    | °C/W |
| $R_{\theta JB}$      | 接合部から基板への熱抵抗        | 605.5         | 541.4         | 566.6                                    | °C/W |
| $\Psi_{JT}$          | 接合部から上面への特性パラメータ    | 118.4         | 64.4          | 78.6                                     | °C/W |
| $\Psi_{JB}$          | 接合部から基板への特性パラメータ    | 591.1         | 527.5         | 552.3                                    | °C/W |
| $R_{\theta JC(bot)}$ | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | 該当なし          | 該当なし          | 該当なし                                     | °C/W |

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

## 5.6 電気的特性 - TSD03

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ       |                                                    | テスト条件                                                                           | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| $V_{RWM}$   | 逆スタンバイオフ電圧                                         | 動作温度範囲全体にわたって、 $I_{IO} = 50\text{nA}$                                           |     |     | 3.6 | V  |
| $V_{BR}$    | ブレイクダウン電圧                                          | $I_{IO} = 1\text{mA}$ 、IO から GND へ                                              | 4.5 |     |     | V  |
| $I_{LEAK}$  | 逆リーク電流                                             | $V_{IO} = 3.6\text{V}$ 、IO から GND へ                                             |     | 5   | 50  | nA |
| $V_{FWD}$   | 順方向電圧                                              | $I_{IO} = 1\text{mA}$ 、GND から IO へ                                              |     | 0.8 |     | V  |
| $V_{CLAMP}$ | サージ クランプ電圧、 $t_p = 8/20\mu\text{s}$ <sup>(2)</sup> | $I_{PP} = 12\text{A}$ 、IO から GND へ                                              |     | 6.3 |     | V  |
|             |                                                    | $I_{PP} = 25\text{A}$ 、IO から GND へ                                              |     | 7.7 |     | V  |
|             |                                                    | $I_{PP} = 12\text{A}$ 、GND から IO へ                                              |     | 3   |     | V  |
|             |                                                    | $I_{PP} = 25\text{A}$ 、GND から IO へ                                              |     | 4.9 |     | V  |
|             | TLP クランプ電圧、 $t_p = 100\text{ns}$                   | $I_{PP} = 16\text{A}$ 、IO から GND へ                                              |     | 6.5 |     | V  |
|             |                                                    | $I_{PP} = 16\text{A}$ 、GND から IO へ                                              |     | 3.4 |     | V  |
| $C_L$       | ライン容量                                              | $V_{IO} = 0\text{V}$ 、 $V_{p-p} = 30\text{mV}$ 、 $f = 1\text{MHz}$ 、IO から GND へ |     | 4.5 |     | pF |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に準拠した非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形

## 5.7 電気的特性 - TSD05

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ       | テスト条件                                              | 最小値                                                    | 標準値 | 最大値 | 単位       |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| $V_{RWM}$   | 逆スタンバイオフ電圧                                         | 動作温度範囲全体にわたって、 $I_{IO} < 50\text{nA}$                  |     |     | 5.5 V    |
| $V_{BR}$    | ブレイクダウン電圧                                          | $I_{IO} = 1\text{mA}$ , IO から GND へ                    |     |     | 6 V      |
| $I_{LEAK}$  | 逆リーク電流                                             | $V_{IO} = 5.5\text{V}$ , IO から GND へ                   |     |     | 5 nA     |
| $V_{FWD}$   | 順方向電圧                                              | $I_{IO} = 1\text{mA}$ , GND から IO へ                    |     |     | 0.7 V    |
| $V_{CLAMP}$ | サージ クランプ電圧、 $t_p = 8/20\mu\text{s}$ <sup>(2)</sup> | $I_{PP} = 24\text{A}$ , I/O から GND へ                   |     |     | 8 11.5 V |
|             |                                                    | $I_{PP} = 60\text{A}$ , I/O から GND へ                   |     |     | 9 15 V   |
|             |                                                    | $I_{PP} = 60\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 5.5 V    |
|             | TLP クランプ電圧、 $t_p = 100\text{ns}$                   | $I_{PP} = 16\text{A}$ , IO から GND へ                    |     |     | 7.5 V    |
|             |                                                    | $I_{PP} = 16\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 2.5 V    |
| $C_L$       | ライン容量                                              | $V_{IO} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$ , IO から GND へ |     |     | 19 pF    |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形

## 5.8 電気的特性 - TSD12

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ       | テスト条件                                              | 最小値                                                    | 標準値 | 最大値 | 単位     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| $V_{RWM}$   | 逆スタンバイオフ電圧                                         | 動作温度範囲全体にわたって、 $I_{IO} < 50\text{nA}$                  |     |     | 12 V   |
| $V_{BR}$    | ブレイクダウン電圧                                          | $I_{IO} = 10\text{mA}$ , IO から GND へ                   |     |     | 12.7 V |
| $I_{LEAK}$  | 逆リーク電流                                             | $V_{IO} = 12\text{V}$ , IO から GND へ                    |     |     | 2 nA   |
| $V_{FWD}$   | 順方向電圧                                              | $I_{IO} = 1\text{mA}$ , GND から IO へ                    |     |     | 0.7 V  |
| $V_{CLAMP}$ | サージ クランプ電圧、 $t_p = 8/20\mu\text{s}$ <sup>(2)</sup> | $I_{PP} = 1\text{A}$ , I/O から GND へ                    |     |     | 18 V   |
|             |                                                    | $I_{PP} = 5\text{A}$ , I/O から GND へ                    |     |     | 19 V   |
|             |                                                    | $I_{PP} = 18\text{A}$ , I/O から GND へ                   |     |     | 23 V   |
|             |                                                    | $I_{PP} = 18\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 8 V    |
|             | TLP クランプ電圧、 $t_p = 100\text{ns}$                   | $I_{PP} = 16\text{A}$ , IO から GND へ                    |     |     | 17 V   |
|             |                                                    | $I_{PP} = 16\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 3 V    |
| $C_L$       | ライン容量                                              | $V_{IO} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$ , IO から GND へ |     |     | 12 pF  |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形

## 5.9 電気的特性 - TSD15

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ       | テスト条件                                             | 最小値                                                    | 標準値 | 最大値 | 単位     |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| $V_{RWM}$   | 逆スタンバイ電圧                                          | 動作温度範囲全体にわたって、 $I_{IO} < 50\text{nA}$                  |     |     | 15 V   |
| $V_{BR}$    | ブレイクダウン電圧                                         | $I_{IO} = 10\text{mA}$ , IO から GND へ                   |     |     | 18.3 V |
| $I_{LEAK}$  | 逆リーク電流                                            | $V_{IO} = 15\text{V}$ , IO から GND へ                    |     |     | 2 nA   |
| $V_{FWD}$   | 順方向電圧                                             | $I_{IO} = 10\text{mA}$ , GND から IO へ                   |     |     | 0.7 V  |
| $V_{CLAMP}$ | サージクランプ電圧、 $t_p = 8/20\mu\text{s}$ <sup>(2)</sup> | $I_{PP} = 1\text{A}$ , I/O から GND へ                    |     |     | 25 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 5\text{A}$ , I/O から GND へ                    |     |     | 26 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 15\text{A}$ , I/O から GND へ                   |     |     | 31 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 15\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 7 V    |
|             | TLP クランプ電圧、 $t_p = 100\text{ns}$                  | $I_{PP} = 16\text{A}$ , IO から GND へ                    |     |     | 23 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 16\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 3 V    |
| $C_L$       | ライン容量                                             | $V_{IO} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$ , IO から GND へ |     |     | 12 pF  |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形

## 5.10 電気的特性 - TSD18

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ       | テスト条件                                             | 最小値                                                    | 標準値 | 最大値 | 単位     |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| $V_{RWM}$   | 逆スタンバイ電圧                                          | 動作温度範囲全体にわたって、 $I_{IO} < 50\text{nA}$                  |     |     | 18 V   |
| $V_{BR}$    | ブレイクダウン電圧                                         | $I_{IO} = 10\text{mA}$ , IO から GND へ                   |     |     | 18.5 V |
| $I_{LEAK}$  | 逆リーク電流                                            | $V_{IO} = 18\text{V}$ , IO から GND へ                    |     |     | 2 nA   |
| $V_{FWD}$   | 順方向電圧                                             | $I_{IO} = 10\text{mA}$ , GND から IO へ                   |     |     | 0.7 V  |
| $V_{CLAMP}$ | サージクランプ電圧、 $t_p = 8/20\mu\text{s}$ <sup>(2)</sup> | $I_{PP} = 1\text{A}$ , I/O から GND へ                    |     |     | 25 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 5\text{A}$ , I/O から GND へ                    |     |     | 26 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 15\text{A}$ , I/O から GND へ                   |     |     | 31 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 15\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 7 V    |
|             | TLP クランプ電圧、 $t_p = 100\text{ns}$                  | $I_{PP} = 16\text{A}$ , IO から GND へ                    |     |     | 23 V   |
|             |                                                   | $I_{PP} = 16\text{A}$ , GND から IO へ                    |     |     | 3 V    |
| $C_L$       | ライン容量                                             | $V_{IO} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$ , IO から GND へ |     |     | 12 pF  |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形

## 5.11 電気的特性 - TSD24

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ              |                                                   | テスト条件                                     | 最小値  | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|-----|----|
| V <sub>RWM</sub>   | 逆スタンバイオフ電圧                                        | 動作温度範囲全体にわたって、I <sub>O</sub> <50nA        |      |     | 24  | V  |
| V <sub>BR</sub>    | ブレイクダウン電圧                                         | I <sub>IO</sub> = 10mA、IO から GND へ        | 24.8 |     |     | V  |
| I <sub>LEAK</sub>  | 逆リーク電流                                            | V <sub>IO</sub> = 24V、IO から GND へ         |      | 2   | 20  | nA |
| V <sub>FWD</sub>   | 順方向電圧                                             | I <sub>IO</sub> = 10mA、GND から IO へ        |      | 0.7 |     | V  |
| V <sub>CLAMP</sub> | サージ クランプ電圧、t <sub>p</sub> = 8/20μs <sup>(2)</sup> | I <sub>PP</sub> = 1A、I/O から GND へ         |      |     | 32  | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 5A、I/O から GND へ         |      |     | 36  | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 9A、I/O から GND へ         |      |     | 39  | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 9A、GND から IO へ          |      |     | 4   | V  |
|                    | TLP クランプ電圧、t <sub>p</sub> = 100ns                 | I <sub>PP</sub> = 16A、IO から GND へ         |      | 33  |     | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 16A、GND から IO へ         |      | 3   |     | V  |
| C <sub>L</sub>     | ライン容量                                             | V <sub>IO</sub> = 0V、f = 1MHz、IO から GND へ |      | 12  |     | pF |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形

## 5.12 電気的特性 - TSD36

$T_A = 25^\circ\text{C}$  (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

| パラメータ              |                                                   | テスト条件                                    | 最小値  | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----|-----|----|
| V <sub>RWM</sub>   | 逆スタンバイオフ電圧                                        | 動作温度範囲全体にわたって、I <sub>O</sub> <50nA       |      |     | 36  | V  |
| V <sub>BR</sub>    | ブレイクダウン電圧                                         | I <sub>O</sub> = 10mA、IO から GND へ        | 37.1 |     |     | V  |
| I <sub>LEAK</sub>  | 逆リーク電流                                            | V <sub>O</sub> = 36V、IO から GND へ         |      | 2   | 20  | nA |
| V <sub>FWD</sub>   | 順方向電圧                                             | I <sub>O</sub> = 10mA、GND から IO へ        |      | 0.7 |     | V  |
| V <sub>CLAMP</sub> | サージ クランプ電圧、t <sub>p</sub> = 8/20μs <sup>(2)</sup> | I <sub>PP</sub> = 1A、I/O から GND へ        |      |     | 44  | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 5A、I/O から GND へ        |      |     | 59  | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 7A、I/O から GND へ        |      |     | 67  | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 7A、GND から IO へ         |      |     | 4   | V  |
|                    | TLP クランプ電圧、t <sub>p</sub> = 100ns                 | I <sub>PP</sub> = 16A、IO から GND へ        |      | 53  |     | V  |
|                    |                                                   | I <sub>PP</sub> = 16A、GND から IO へ        |      | 3   |     | V  |
| C <sub>L</sub>     | ライン容量                                             | V <sub>O</sub> = 0V、f = 1MHz、IO から GND へ |      | 12  |     | pF |

(1) 標準のパラメータは  $25^\circ\text{C}$  で測定されたものです

(2) IEC 61000-4-5 に従う非反復的な電流パルスの  $8 \sim 20\mu\text{s}$  の指数減衰波形



## 5.13 代表的特性

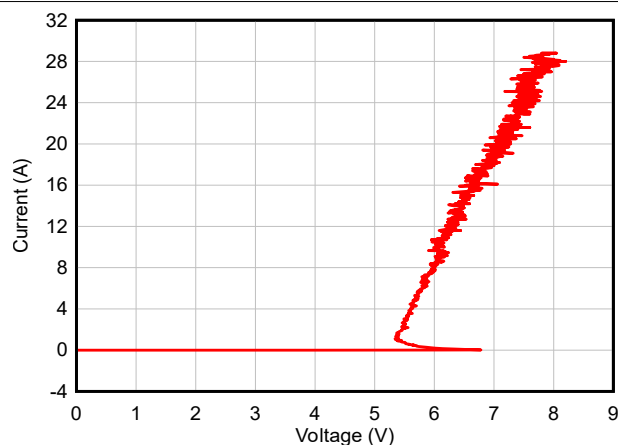


図 5-1. 正の TLP 曲線 - TSD03

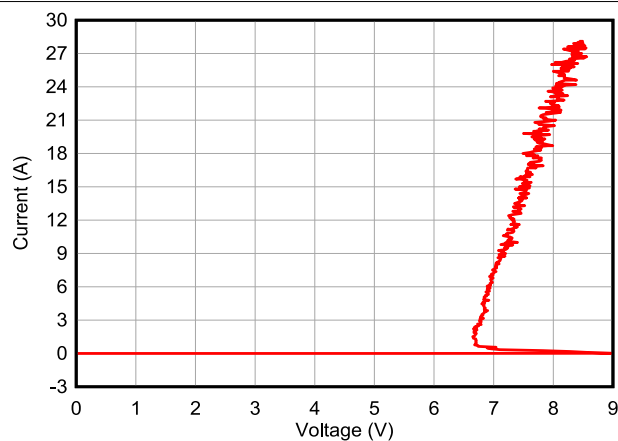


図 5-2. 正の TLP 曲線 - TSD05

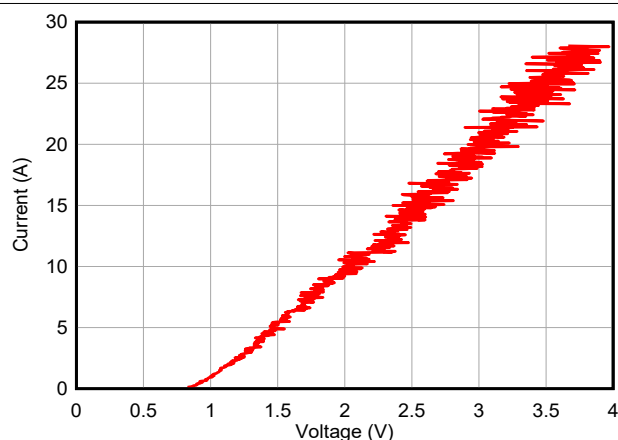


図 5-3. 負の TLP 曲線 - TSD05

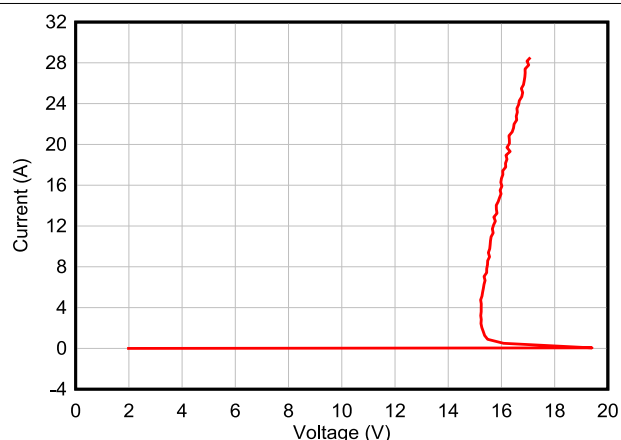


図 5-4. 正の TLP 曲線 - TSD12

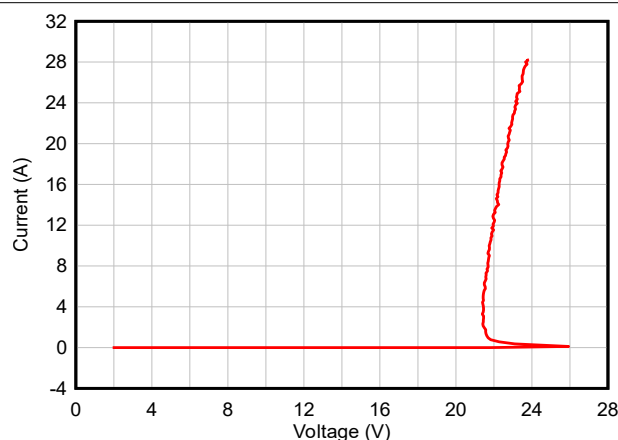


図 5-5. 正の TLP 曲線 - TSD15

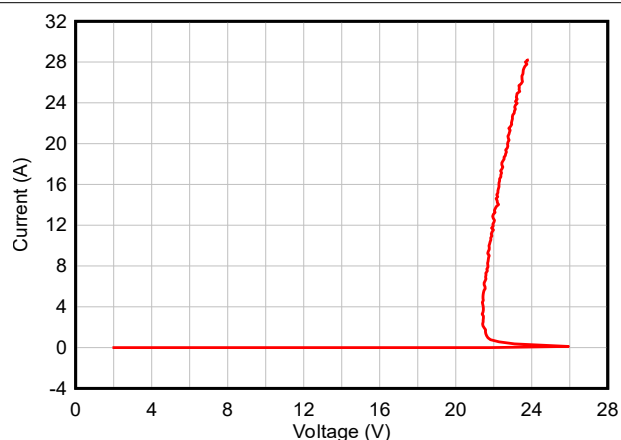


図 5-6. 正の TLP 曲線 - TSD18

## 5.13 代表的特性 (続き)

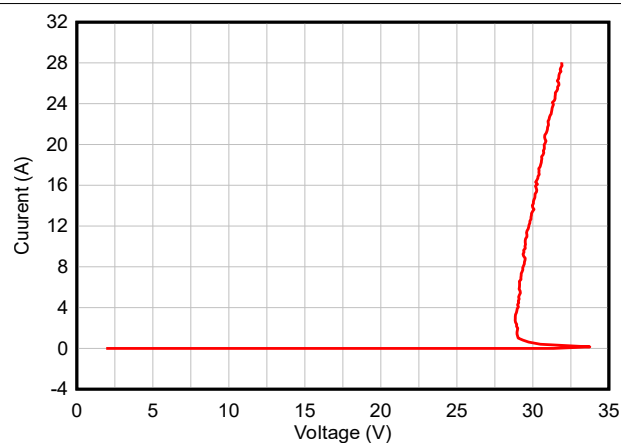


図 5-7. 正の TLP 曲線 - TSD24

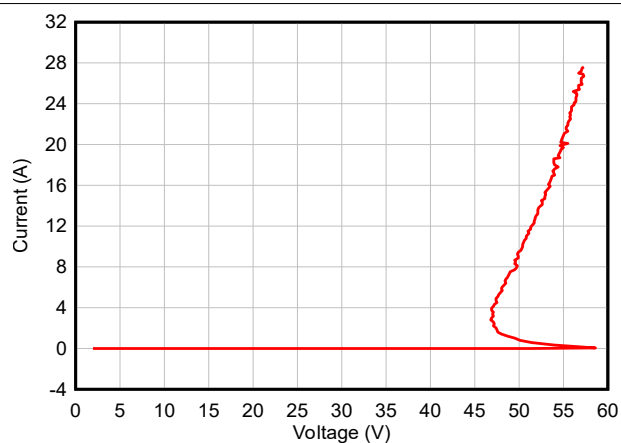


図 5-8. 正の TLP 曲線 - TSD36

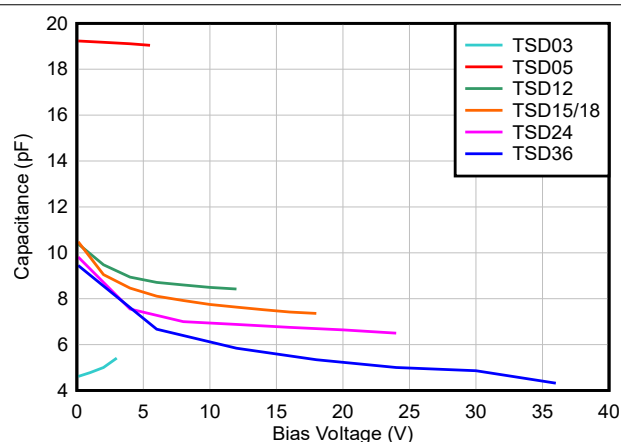


図 5-9. 静電容量とバイアス電圧との関係

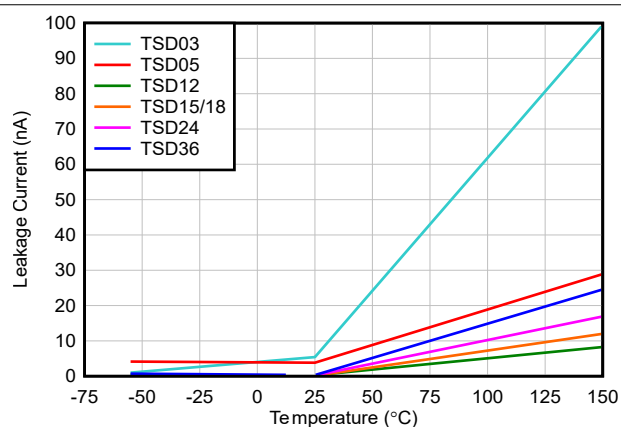


図 5-10. リーク電流と温度との関係

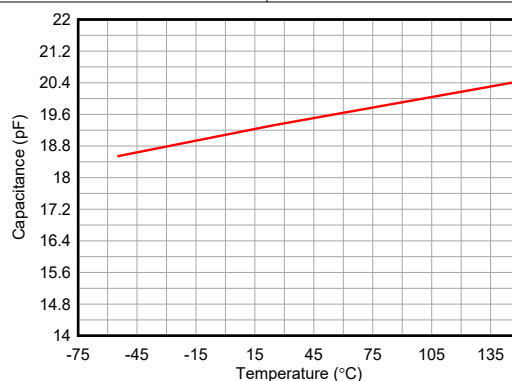


図 5-11. 温度と静電容量との関係 - TSD05

## 6 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 6.1 アプリケーション情報

TSDxx ファミリーは、信号ラインおよび電源ラインで (ESD やサージなどの) 過渡電圧スパイクを放散するためのグラウンドへの経路を提供する TVS ダイオードです。保護のため、デバイスを下流回路と並列に接続します。過渡電流が TVS を通過するため、ダイオードの両端ではわずかな電圧降下が発生します。保護された IC にわずかな電圧降下が与えられます。トリガされた TVS の  $R_{\text{DYN}}$  が低いと、この電圧 ( $V_{\text{CLAMP}}$ ) は、保護された IC に対して安全なレベルに保持されます。このデバイスの適切な使用方法については、『[ESD パッケージングおよびレイアウト ガイド](#)』を参照してください。

## 7 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 7.1 ドキュメントのサポート

#### 7.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[ESD レイアウト ガイド](#)』アプリケーション レポート
- テキサス・インスツルメンツ、『[汎用 ESD 評価基板ユーザー ガイド](#)』
- テキサス・インスツルメンツ、『[ESD 保護の読み取りと理解](#)』データ シート

### 7.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 7.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 7.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 7.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 7.6 用語集

#### テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 8 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

### Changes from Revision B (March 2025) to Revision C (May 2025) Page

- デバイス リストに TSD12、TSD15、TSD18、TSD24、TSD36 を追加..... [1](#)

### Changes from Revision A (January 2025) to Revision B (March 2025) Page

- TSD03 デバイスを追加..... [1](#)

### Changes from Revision \* (July 2023) to Revision A (January 2025) Page

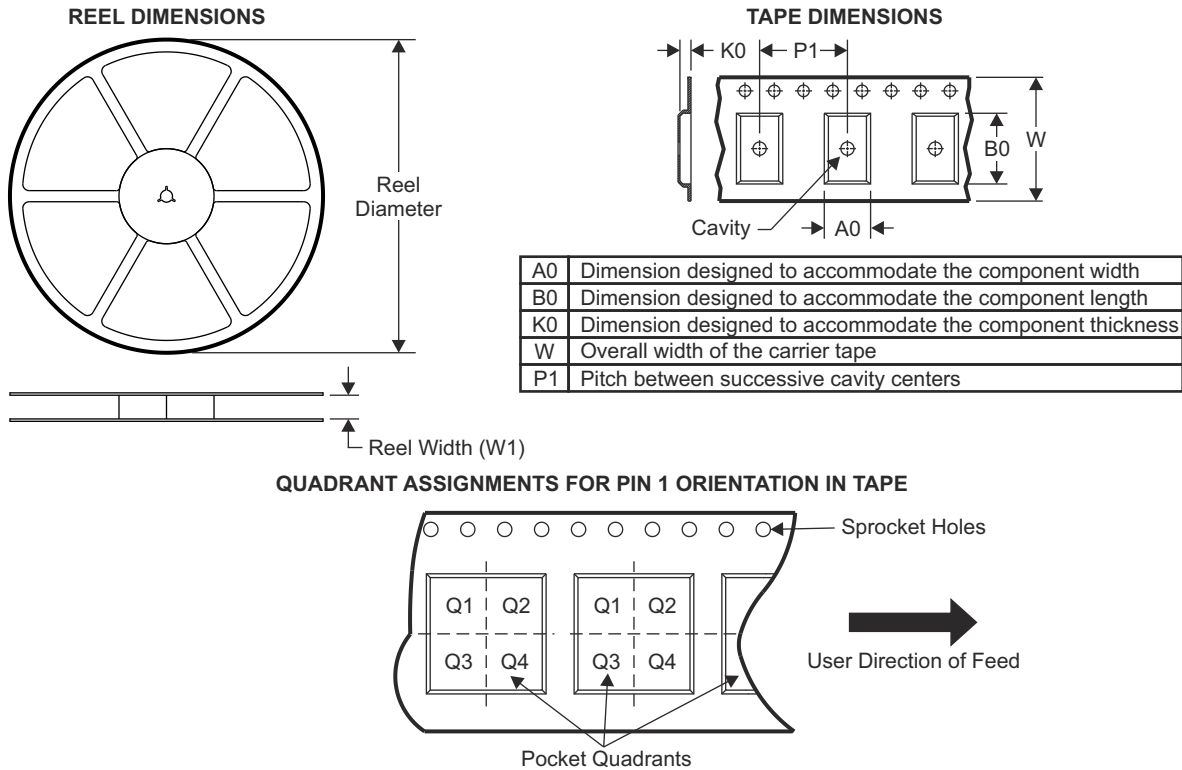
- 電気的特性を更新..... [6](#)

| 日付         | 改訂 | 注      |
|------------|----|--------|
| 2023 年 7 月 | *  | 初版リリース |

## 9 メカニカル、パッケージ、および注文情報

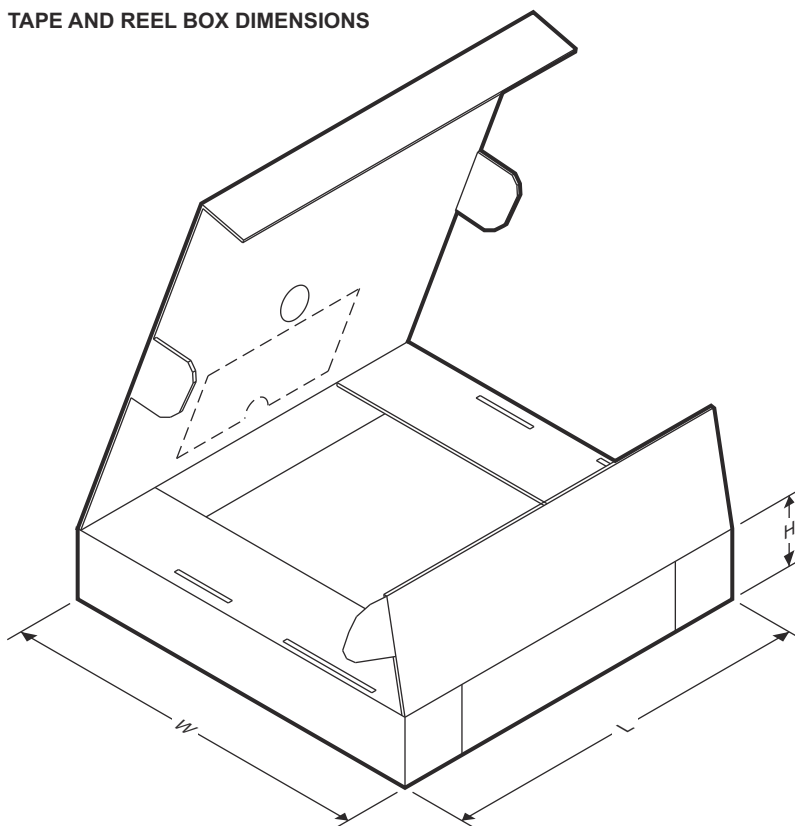
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

### 9.1 テープおよびリール情報



| デバイス      | パッケージ<br>タイプ | パッケージ<br>図 | ピン | SPQ   | リール直径<br>(mm) | リール幅 W1<br>(mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | 幅 W (mm) | ピン 1 の象限 |
|-----------|--------------|------------|----|-------|---------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| TSD05DYFR | SOD-323      | DYF        | 2  | 15000 | 178           | 8.4             | 0.36    | 0.66    | 0.33    | 0.2     | 8        | Q1       |

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



| デバイス      | パッケージタイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ   | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|-----------|----------|--------|----|-------|---------|--------|---------|
| TSD05DYFR | SOD-323  | DYF    | 2  | 15000 | 205     | 200    | 33      |

## 9.2 メカニカル データ

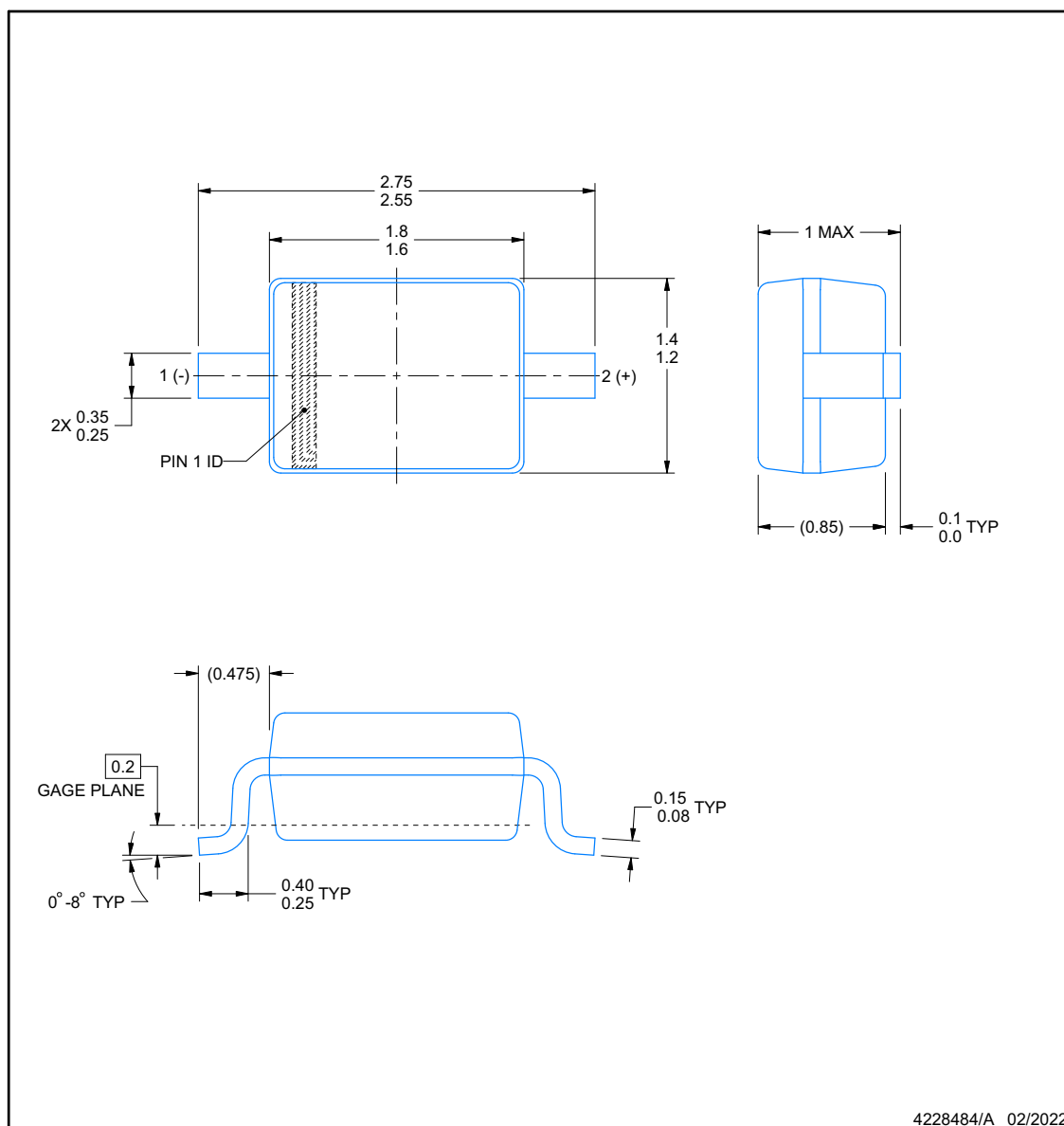


**DVF0002A**

### PACKAGE OUTLINE

**SOT(SOD-323) - 1 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4228484/A 02/2022

#### NOTES:

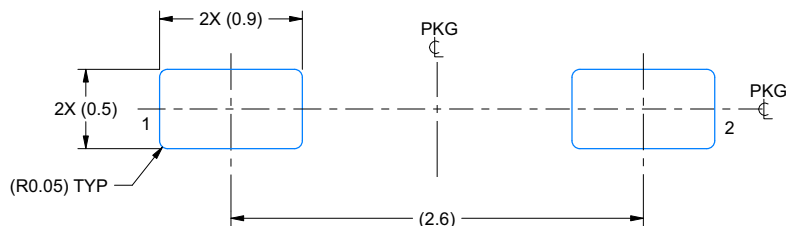
- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.

## EXAMPLE BOARD LAYOUT

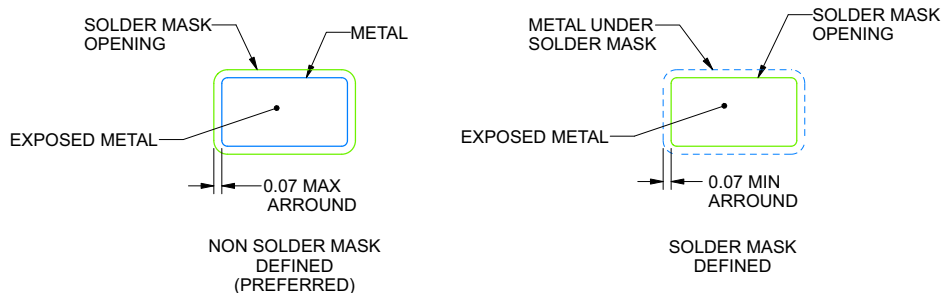
**DYF0002A**

**SOT(SOD-323) - 1 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE  
 EXPOSED METAL SHOWN  
 SCALE:25X



SOLDER MASK DETAILS

4228484/A 02/2022

NOTES: (continued)

3. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
4. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

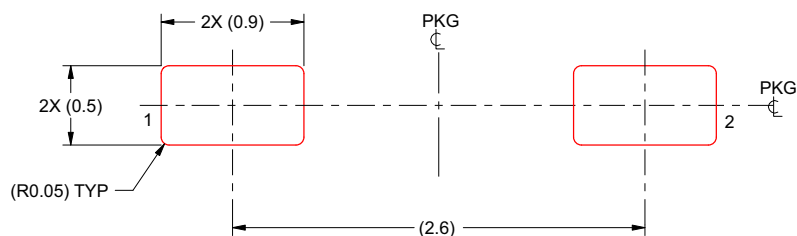


## EXAMPLE STENCIL DESIGN

**DYF0002A**

**SOT(SOD-323) - 1 mm max height**

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



**SOLDER PASTE EXAMPLE**  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:25X

4228484/A 02/2022

NOTES: (continued)

5. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
6. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

## PACKAGING INFORMATION

| Orderable part number     | Status<br>(1) | Material type<br>(2) | Package   Pins | Package qty   Carrier | RoHS<br>(3) | Lead finish/<br>Ball material<br>(4) | MSL rating/<br>Peak reflow<br>(5) | Op temp (°C) | Part marking<br>(6) |
|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| <a href="#">TSD03DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 3N5F                |
| TSD03DYFR.B               | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 3N5F                |
| <a href="#">TSD05DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 33MF                |
| TSD05DYFR.B               | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -40 to 125   | 33MF                |
| <a href="#">TSD12DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -55 to 150   | 3JIF                |
| <a href="#">TSD15DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -55 to 150   | 3MOF                |
| <a href="#">TSD18DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -55 to 150   | 3JLF                |
| <a href="#">TSD24DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -55 to 150   | 3H2F                |
| <a href="#">TSD36DYFR</a> | Active        | Production           | SOT (DYF)   2  | 3000   LARGE T&R      | Yes         | SN                                   | Level-3-260C-168 HR               | -55 to 150   | 3GJF                |

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TSD12, TSD15, TSD18, TSD24, TSD36 :**

- Automotive : [TSD12-Q1](#), [TSD15-Q1](#), [TSD18-Q1](#), [TSD24-Q1](#), [TSD36-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

## 重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated